

PCT/FR2004/001677

REC'D 0 4 OCT 2004

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

> 0 9 JUIL. 2004 Fait à Paris, le

> > Pour le Directeur général de l'institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

> > > **Martine PLANCHE**

OCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

210:

REMISE DES PIÈCI	Réservé à l'INPI		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire pp. 540 @W		
DATE			NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUD OU DU MANTE		
LIEU TO LE	JIL 2003		À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE		
N° D'ENREGISTREI	PI GRENOBLE		Cabinet Hecké		
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0308134			World Trade Center - Europole		
DATE DE DÉPÔT AT			5, place Robert Schuman		
PAR L'INPI	o Juit. 50		BP 1537		
Vos référence (facultatif)	es pour ce dossier PA18	05FR	38025 Grenoble Cedex 1		
Confirmation	ı d'un dépôt par télécopie	□ N° attribué par			
2 NATURE	NATURE DE LA DEMANDE		- The state par First a la telecople		
	de brevet	Cochez l'une des	Cochez J'une des 4 cases suivantes		
	de certificat d'utilité		The state of the s		
	divisionnaire	<u> </u>			
Demande	divisionnaire				
	Demande de brevet initial	le Nº			
. oud	lemande de certificat d'utilité initial	e N°	. Date		
Transform	ation d'une demande de		Date		
brevet eur	opéen Demande de brevet initiale	No .	The state of the s		
3 TITRE DE	L'INVENTION (200 caractères	Oll Achagon movies	Date comportant un support de mémoire		
4 DÉCLARAT	TION DE PRIORITÉ	Pays ou organisation			
	TE DU BÉNÉFICE DE	Date	No		
	E DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation	·		
		Date	N°.		
PEMAINE	ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	•		
		Date	N°		
E DEMANDE	The state of the s	S'il y a d'autr	es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		
	UR (Cochez l'une des 2 cases)	Personne mor	ale Personne physique		
Nom ou dénomin:	ation sociale				
Prénoms	· · ·	Commissariat	à l'Energie Atomique		
Forme juridic	auo.				
N° SIREN	que	Etablissement Public de	Caractère scientifique, technique et industriel		
Code APE-NAF					
	1				
Domicile	Rue	31- 33 rue de	la Fédération		
ou siège	Code postal et ville				
0.080	Pays	75752 Paris			
Nationalité		francoica			
in de reieblioue (lacultalit)		française			
Adresse électronique (facultatif)		••••	N° de télécopie (facultatif)		
		S'il y a plus d'un d	emandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		
			"Suite" (Suite)		



Réservé à l'INPI

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



1	E DES PIÈCES	Reserve a HNPI						
DATE	3 JUIL	2003						
LIEU		RENOBLE						
No D.E	ENREGISTREMENT	03081:	7 A		DAROCEE			
	NAL ATTRIBUÉ PAR I		## ##		PA1805FR	OB 540 W / 210502		
6	WANDATAIRE	(s'il y a lieu)			To seed on the section of these section is the first of section (product) (p	The second second features are as as a second secon		
	Nom	•	•	Hecké	•••	Jouvray		
•	Prénom) e spokke ndernden e ve de delege oos o		Gérard	to the winds amore analysis on a some age.	Marie-Andrée		
	Cabinet ou So	ciété				maile-Anaice		
				Cabinet Hecké (S.A.)				
	N °de pouvoir	permanent et/ou			• • • •	·		
	de lien contrac	ctuel						
1		Rue		World Trade	e Center - Euro	pole		
	Adresse			5, place Robert Schuman - BP 1537				
	Auresse	Code postal et ville		38025 Grenoble Cedex				
		Pays		France				
	N° de téléphor	ne <i>(facultatif)</i>		04 76 84 95	5 45			
	N° de télécopie (facultatif)		,	04 76 84 95		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Adresse électronique (facultatif)			hecke@dial	.oleane.com			
72				Les inventeurs so	ont nécessairement des	personnes physiques		
	Les demander	irs et les inventeurs		□ Oui				
	sont les même				ce cas remplir le formul	aire de Désignation d'inventeur(s)		
8	in the second control of the second control							
					' and denigniae he bleke	r (A combine araisión et rististolius nou)		
	Etablissement immédiat ou établissement différé							
	Paiement échelonné de la redevance (en deux rersements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt Oui					
		en ueux (eisemens)		Non ■ Non Non				
9	RÉDUCTION DU TAUX		Uniquement pou	r les personnes physiqu	es			
	DES REDEVA	NCES		Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)				
			☐ Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la					
į				décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG				
10	SÉQUENCES	DE NUCLEOTIDES						
		DES AMINÉS		Cochez la case	si la description contient	une liste de séquences		
	Le support éle	ctronique de données e	est ioint					
		de conformité de la lis	- i					
1	séquences su	ir support papier ave	ec le					
	support électr	onique de données est	jointe					
		utilisé l'Imprimé «Su	-					
		ombre de pages join	ites					
Ħ			ard Haal-4		VISA DE LA PRÉFECTURE			
			ard Hecké		OU DE L'INPI			
(Nom et qualité du signataire) CPI			95-1201					
	Mar CPI			ie Andrée J	ouvray			
					Juviay			
				W1-0410				

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Dispositif d'enregistrement de données comportant un support de mémoire déformable

Domaine technique de l'invention

L'invention concerne un dispositif d'enregistrement de données comportant un réseau de micro-pointes, de dimension d'apex nanométrique, disposé dans un plan face à un support de mémoire.

État de la technique

L'enregistrement de données, aussi bien dans le domaine de l'informatique que dans le domaine des multimédias, doit répondre à un besoin croissant de capacité. Différentes techniques ont été développées, allant du disque dur magnétique au DVD utilisant l'optique et des matériaux à changement de phase. Quelle que soit la technique d'enregistrement utilisée, on cherche toujours à réduire la taille des points mémoires (bits) et l'accroissement de la capacité d'enregistrement passe par une augmentation de la densité de stockage.

20

25

15

5

10

Récemment, de très grandes capacités de stockage, de l'ordre du Térabit/cm², ont été obtenues en mettant en œuvre des micro-pointes du type utilisées dans le domaine de la microscopie à effet de pointe (« The Millipede – More than one thousands tips for future AFM data storage », P. Vettiger et al., IBM J. RES. Develop., vol.44, n° 3, mai 2000, p.323-340 et « Fabrication of microprobe array with sub-100nm nano-heater for nanometric thermal imaging and data storage », Dong-Weon Lee et al., Technical Digest, MEMS 2001, 14th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical, Systems (Cat.

N°01CH37090), IEEE, Piscataway, NJ, USA, 2001, p.204-207). La haute densité est obtenue par localisation des bits au moyen de micro-pointes dont l'apex est de dimension nanométrique. Les micro-pointes sont, de préférence, disposées en réseau bidimensionnel, avec un accès parallèle aux données, ce qui permet d'atteindre d'excellentes performances en ce qui concerne le débit. Un actionneur unique, qui peut être électromécanique, permet un déplacement relatif monolithique de l'ensemble du réseau de micro-pointes par rapport à la surface du média constituant le support de mémoire.

5

20

Dans un tel dispositif d'enregistrement de données, avec effet de pointes, il est nécessaire de garantir un parfait contact de toutes les pointes avec le support de mémoire. Pour des raisons de complexité du système, il n'est pas envisageable de contrôler la position de chaque micro-pointe individuellement. Or, les micro-pointes sont fabriquées de manière collective, par des techniques dérivées de celles de la microélectronique, et il reste toujours une dispersion, due à la fabrication, de la hauteur des micro-pointes. Bien que cette dispersion soit minime, typiquement de l'ordre de 100nm, la plus longue des micro-pointes d'un réseau appuie plus que les autres sur le support de mémoire.

Pour surmonter cette difficulté, chaque micro-pointe est portée en porte-à-faux par une extrémité d'un cantilever, de manière analogue aux réseaux de micro-pointes utilisés en microscopie à sonde locale. La souplesse du cantilever permet alors d'absorber la contrainte d'un appui.

Cependant, les forces d'appui des micro-pointes sur le support de mémoire ne doivent pas excéder une valeur de l'ordre de 100nN par exemple, de manière à ne pas endommager le support de mémoire. En effet, la surface de contact d'une micro-pointe avec le support de mémoire étant minuscule, la pression est importante. Les cantilevers doivent donc être très souples pour absorber la

dispersion de hauteur des micro-pointes. À titre d'exemple, des cantilevers ayant une raideur de l'ordre de 1N/m, 100µm de longueur, quelques dizaines de µm de largeur et quelques µm d'épaisseur, ont été développés. Il est difficile d'envisager des cantilevers plus souples. En effet, leurs dimensions sont difficiles à maîtriser en raison de leur grande longueur vis-à-vis de leur faible largeur et/ou épaisseur. De plus, la précision de positionnement des pointes en regard de la surface du support de mémoire s'en ressentirait, limitant ainsi la densité de la mémoire.

10

5

Objet de l'invention

L'invention a pour but un dispositif d'enregistrement de données ne présentant pas les inconvénients ci-dessus et permettant plus particulièrement d'ignorer la dispersion dans la hauteur des micro-pointes.

Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que le support de mémoire est constitué par un empilement de couches minces comportant au moins une couche mémoire déformable déposée sur un substrat.

20

25

15

Dans un mode particulier de réalisation, la couche mémoire est déposée sur une couche souple, déposée sur le substrat.

Selon un développement de l'invention, le support de mémoire comporte une couche d'interface avec les micro-pointes, recouvrant la couche mémoire.



Description sommaire des dessins

5

15

20

25

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés au dessin annexé, dans lequel la figure unique illustre un mode de réalisation particulier d'un support de mémoire d'un dispositif selon l'invention.

Description d'un mode particulier de réalisation.

Le support de mémoire 1 selon l'invention est un support de mémoire déformable, absorbant la dispersion de hauteur des micro-pointes. Il est constitué par un empilement de couches minces comportant au moins une couche mémoire déformable déposée sur un substrat 4.

La couche mémoire déformable peut être constituée par une couche mémoire souple ou, comme représenté sur la figure, par un empilement d'une couche mémoire 2 et d'une couche souple 3, cette dernière étant déposée sur le substrat 4. Une couche 5, d'interface avec les micro-pointes 6, peut recouvrir la couche mémoire 2. L'appui d'une micro-pointe 6 sur le support de mémoire 1 se traduit alors par une déformation progressive de l'empilement, jusqu'à la couche souple 3. Cette déformation progressive est fonction de la dureté et de l'épaisseur des différentes couches. La constitution et l'épaisseur des différentes couches de l'empilement sont adaptées aux fonctionnalités recherchées et, en particulier, au mode d'enregistrement choisi (thermique, électrique).

La couche souple 3 peut être constituée par une couche de polymère. À titre d'exemple, elle peut être constituée par de la résine photosensible, notamment

de la résine photosensible utilisée en microélectronique dans les procédés de détachement de type "liftoff". Elle peut également être constituée par une colle de dureté contrôlée ou par une couche de silicone élastomère de type PDMS. La couche souple 3 est, de préférence, déposée sur le substrat 4 par dépôt tournette ("spin coating") ou par projection ("spray"). Son épaisseur dépend de la souplesse recherchée et peut, par exemple, être de l'ordre de quelques micromètres ou même moins si nécessaire.

5

10

15

20

25

Le substrat 4 peut être en silicium ou en matière plastique, éventuellement souple, par exemple en polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Dans ce cas, sa souplesse peut contribuer à la souplesse de l'empilement constituant le support de mémoire 1 et son épaisseur peut être réduite à moins d'un millimètre.

La constitution de la couche mémoire 2 dépend du processus d'enregistrement des données choisi. Cette couche peut notamment être en polymère ou en matériau à changement de phase, isolant ou conducteur. Dans tous les cas, la couche mémoire doit être aussi fine que possible pour conserver la souplesse requise du support de mémoire. Elle a ainsi généralement une épaisseur inférieure au micromètre. Elle peut, par exemple, être déposée par PVD, par exemple par pulvérisation cathodique, par PECVD ou par dépôt tournette sur la couche souple 3.

Si le processus d'écriture choisi est un processus d'écriture électrique, il peut être nécessaire de rendre conductrice la couche souple 3. Ceci peut notamment être réalisé par le choix d'un matériau polymère conducteur, par l'addition d'un additif dans le matériau initialement isolant ou par interposition d'une couche conductrice additionnelle (non représentée) entre la couche mémoire 2 et la couche souple 3. Une telle couche conductrice additionnelle peut, par exemple,

TOI GOPOL

être une couche de carbone, de nature adaptée à la conduction, et de faible épaisseur (quelques dizaines de nanomètres).

6

La constitution de la couche d'interface 5 est destinée à faciliter l'interaction des micro-pointes 6 et du support de mémoire. À titre d'exemple, la couche d'interface 5 peut être en carbone, en polymère, ... Quelle que soit sa nature, elle devra être aussi fine que possible pour ne pas rigidifier le support de mémoire 1.

5

Revendications

5

15

- 1. Dispositif d'enregistrement de données comportant un réseau de micropointes (6), de dimension d'apex nanométrique, disposé dans un plan face à un
 support de mémoire (1), dispositif caractérisé en ce que le support de mémoire
 (1) est constitué par un empilement de couches minces comportant au moins
 une couche mémoire déformable (2) déposée sur un substrat (4).
- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couche mémoire
 est déposée sur une couche souple (3), déposée sur le substrat (4).
 - 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que la couche souple (3) est en polymère.
 - 4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que la couche souple (3) est en résine photosensible.
- 5. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que la couche souple
 20 (3) est une colle de dureté contrôlée.
 - 6. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que la couche souple (3) est en silicone élastomère.
- 7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que la couche souple (3) a une épaisseur de l'ordre de quelques micromètres.
 - 8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que la couche souple (3) est conductrice.

ivi uvpui

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte une couche conductrice additionnelle entre la couche mémoire (2) et la couche souple (3).

5

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la couche mémoire (2) a une épaisseur inférieure au micromètre.

10

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comporte une couche (5) d'interface avec les micro-pointes (6), recouvrant la couche mémoire (2).

12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en

ce que le substrat (4) est en silicium.

15

13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que le substrat (4) est en matière plastique, de moins d'un millimètre d'épaisseur.

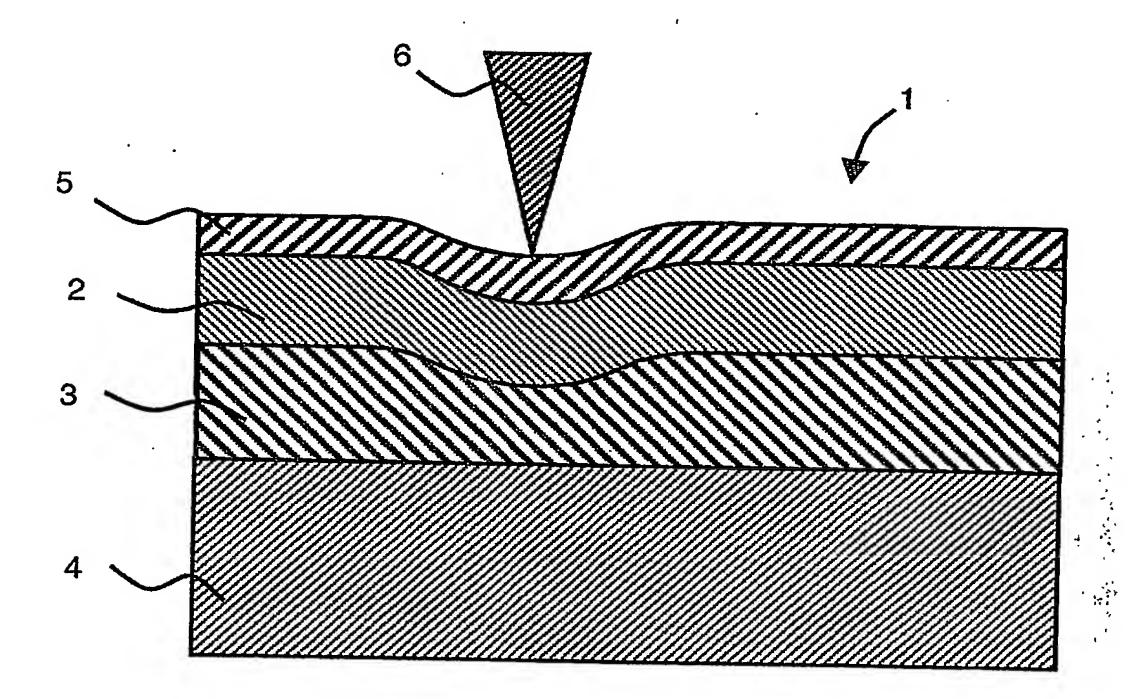


Figure unique



BREVET D'INVENTION





DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1/ 1

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cat imprimé act à remalie lisible

Vos référence	s pour ce dossier (facultatif)	DA 100 FFD	OB 113 @ W / 270601
N° D'ENREGIS	TREMENT NATIONAL	PA1805FR 0308134	
TITRE DE L'IN	VENTION (200 caractères ou es	maces maximum)	
		de données comportant un support de mémoire	
15(0) 5555			
•	eriat à l'Energie A		
Nom	The man do marrateoul	·	
Prénoms		Gidon	
7.000113		Serge	
Adresse	Rue	8, Le Petit Bois	
Sociátá dl	Code postal et ville	38140 La Murette	
	partenance (facultatif)		
Nom Prénoms			
Adresse	Rue		
Société d'an	Code postal et ville		
Nom	partenance (facultatif)		
Prénoms			
Adresse	Rue		
Secilia :	Code postal et ville		
	partenance (facultatif)		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		Gérard Hecké CPI 95-1201 CPI 01-0410	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT/FR2004/001677